

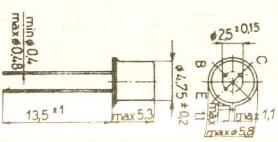
# KC 507, KC 508, KC 509 NPN – PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

NPN – ТРАНЗИСТОРЫ ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ • NPN – GENERAL-PURPOSE TRANSISTORS • NPN – TRANSISTOREN FÜR UNIVERSALBENUTZUNG

**Polevodidlové součástky TESLA KC 507, KC 508 a KC 509 jsou křemíkové epitaxní plánární tranzistory NPN, určené především pro vstupní obvody nízkofrekvenčních zesilovačů.**

Tranzistory jsou zapouzdřeny v kovovém pouzdru K 507/P 206 se skleněnou průchodekou a třemi vývody. Kolktor je vodivě spojen s pouzdrem.

Tranzistory zapouzdřené v dojázené patici mohou mít rozdíl rozečte kružnice vývodů  
2,5 ± 0,25 mm



## Meziní hodnoty:

Teploota okolí +25 °C

	KC 507	KC 508	KC 509
Závérné napětí kolektoru špičkové	45	20	V
Závérné napětí kolektoru	45	20	V
Napětí emitoru	5	V	V
Proud kolektoru	100	mA	mA
Špičkový impulsní	200	mA	mA
Proud emitoru	100	mA	mA
Špičkový	200	mA	mA
Proud báze	15	mA	mA
Špičkový	20	mA	mA
S ideálním chlazením $T_a \leq 115^\circ\text{C}$	300	mW	mW
Teplotní odpor vnitřní	200	°C/W	°C/W
Teplota přechodu	175	°C	°C
Teplota při skladování	-55 ... +175		

## Charakteristické údaje:

Teplota okolí +25 °C

Jmenovité hodnoty:	KC 507	KC 508	KC 509
Závérné napětí kolektoru • ( $I_{CE} = 15 \text{ nA}$ ) • ( $I_{CE} = 2 \text{ mA}$ )	$U_{CEO}$ >45	$U_{CEO}$ >45	$U_{CEO}$ >45
Závérné napětí emitoru • ( $I_{EE} = 1 \mu\text{A}$ )	$U_{EBO}$ >5	$U_{EBO}$ >5	$U_{EBO}$ >5
Proud báze • ( $U_{CE} = 5 \text{ V}$ , $I_E = 10 \mu\text{A}$ ) • ( $U_{CE} = 5 \text{ V}$ , $I_E = 10 \mu\text{A}$ )	$I_{B1}$ 0,5 $I_{B2}$ <16	$I_{B1}$ 0,5 $I_{B2}$ <16	$I_{B1}$ 0,5 $I_{B2}$ <9

## Informativní hodnoty:

Zbytkový proud kolektoru ( $U_{CB} = 45 \text{ V}$ , $T_a = 150^\circ\text{C}$ ) ( $U_{CB} = 20 \text{ V}$ , $T_a = 150^\circ\text{C}$ )	$I_{CBO}$	$I_{CBO}$	$I_{CBO}$
Proud báze ( $U_{CE} = 5 \text{ V}$ , $I_c = 0,01 \text{ mA}$ )	$I_{BE1}$	$I_{BE1}$	$I_{BE1}$
( $U_{CE} = 5 \text{ V}$ , $I_c = 2 \text{ mA}$ )	$I_{BE2}$	$I_{BE2}$	$I_{BE2}$
( $U_{CE} = 5 \text{ V}$ , $I_c = 20 \text{ mA}$ )	$I_{BE3}$	$I_{BE3}$	$I_{BE3}$
( $U_{CE} = 5 \text{ V}$ , $I_c = 100 \text{ mA}$ )	$I_{BE4}$	$I_{BE4}$	$I_{BE4}$
Vstupní kapacita ( $U_E = 0,5 \text{ V}$ , $f = 1 \text{ MHz}$ )	$C_{EB0}$	$C_{EB0}$	$C_{EB0}$

## Klimatické vlastnosti:

Kategorie odolnosti proti vnějším vlivům podle ČSN 35 8031: 55/175/21. Zkouší se podle ČSN 34 5681 při zkouškách kontrolních a přejmacích se zkouškách se zrychlením 10 g při krmitočtu 50 Hz vždy po 30 minutach ve směru hlavní osy a v jednom libovolném směru, kolmém na hlavní osu. Při zkouškách se kontrolují elektrické parametry jmenovitých hodnot  $U_{CEO}$ ,  $U_{CEO}$ ,  $I_{B2}$ ,  $U_{CES2}$ . Po zkoušce SC5 se připojuje bodová koroze.

## Mechanické vlastnosti:

Tranzistory jsou odolné proti účinkům chvění a otřesům se zrychlením až do 10 g. Při zkouškách kontrolních a přejmacích se zkouší se se zrychlením 10 g při krmitočtu 50 Hz vždy po 30 minutach ve směru hlavní osy a v jednom libovolném směru, kolmém na hlavní osu. Při zkoušce jsou provédy mimo provoz. Dále jsou odolné proti účinkům pádu až do hodiny 100 g (zkouší se podle ČSN 34 5681 čl. 80, zkouška PE3).